

# Физика и техника полупроводников, 2017, том 51, выпуск 11

XXI Международный симпозиум "Нанозфизика и нанозлектроника", Нижний Новгород, 13-16 марта 2017 г.

- Звонков Б.Н., Байдусь Н.В., Некоркин С.М., Вихрова О.В., Здоровейцев А.В., Кудрин А.В., Котомина В.Е.  
**XXI Международный симпозиум Нанозфизика и нанозлектроника", Нижний Новгород, 13-16 марта 2017 г. Оптический тиристор на основе системы материалов GaAs/InGaP** 1443
- Горшков А.П., Волкова Н.С., Воронин П.Г., Здоровейцев А.В., Истомин Л.А., Павлов Д.А., Усов Ю.В., Левичев С.Б.  
**Влияние состава покровного слоя на электронные характеристики квантовых точек InAs/GaAs** 1447
- Деребезов И.А., Гайслер В.А., Гайслер А.В., Дмитриев Д.В., Торопов А.И., Fischbach S., Schlehahn A., Kaganskiy A., Heindel T., Bounouar S., Rodt S., Reitzenstein S.  
**Сверхминиатюрные излучатели на основе одиночной (111) In(Ga)As квантовой точки и гибридного микрорезонатора** 1451
- Ерофеева И.В., Дорохин М.В., Лесников В.П., Кузнецов Ю.М., Здоровейцев А.В., Питиримова Е.А.  
**Термоэлектрические эффекты в наноразмерных слоях силицида марганца** 1456
- Дегтярев В.Е., Хазанова С.В., Конаков А.А.  
**Влияние электрического поля на соотношение параметров Рашба и Дрессельхауза в гетероструктурах  $A^mB^v$**  1462
- Калентьева И.Л., Вихрова О.В., Данилов Ю.А., Звонков Б.Н., Кудрин А.В., Дорохин М.В., Павлов Д.А., Антонов И.Н., Дроздов М.Н., Усов Ю.В.  
**Особенности селективного легирования марганцем GaAs структур** 1468
- Комков О.С., Кудрин А.В.  
**Бесконтактная характеристика дельта-слоев марганца и углерода в арсениде галлия** 1473
- Лещенко Е.Д., Дубровский В.Г.  
**Неоднородное распределение легирующей примеси в  $A^mB^v$  нитевидных нанокристаллах** 1480
- Малеев Н.А., Беляков В.А., Васильев А.П., Бобров М.А., Блохин С.А., Кулагина М.М., Кузьменков А.Г., Неведомский В.Н., Гусева Ю.А., Малеев С.Н., Ладенков И.В., Фефелова Е.Л., Фефелов А.Г., Устинов В.М.  
**Молекулярно-пучковая эпитаксия структур InGaAs/InAlAs/ AlAs для гетеробарьерных варакторов** 1484
- Забавичев И.Ю., Оболенская Е.С., Потехин А.А., Пузанов А.С., Оболенский С.В., Козлов В.А.  
**Транспорт горячих носителей заряда в Si, GaAs, InGaAs и GaN субмикронных полупроводниковых структурах с нанометровыми кластерами радиационных дефектов** 1489
- Павельев Д.Г., Васильев А.П., Козлов В.А., Оболенская Е.С., Оболенский С.В., Устинов В.М.  
**Оптимизация параметров сверхрешетки для диодов терагерцового диапазона частот** 1493
- Алешкин В.Я., Гавриленко Л.В.  
**Каскадный захват электронов на заряженные диполи в слабо компенсированных полупроводниках** 1498
- Охапкин А.И., Королёв С.А., Юнин П.А., Дроздов М.Н., Краев С.А., Хрыкин О.И., Шашкин В.И.  
**Низкотемпературное осаждение пленок  $SiN_x$  в индуктивно-связанной плазме  $SiH_4/Ar + N_2$  в условиях сильного разбавления силана аргонем** 1503
- Алексеев А.Н., Мамаев В.В., Петров С.И.  
**Исследование влияния сурфактанта Ga при высокотемпературной аммиачной молекулярно-лучевой эпитаксии слоев AlN на свойства нитридных гетероструктур** 1507
- Планкина С.М., Вихрова О.В., Звонков Б.Н., Нежданов А.В., Пашенькин И.Ю.  
**Применение спектроскопии фотолюминесценции для исследования поперечного скола многослойных гетероструктур** 1510
- Полищук О.В., Фатеев Д.В., Попов В.В.  
**Усиление терагерцового излучения в плазмонной n-i-p-i-структуре на основе графена с инжекцией носителей заряда** 1514

- Забавичев И.Ю., Потехин А.А., Пузанов А.С., Оболенский С.В., Козлов В.А.  
**Деградация характеристик биполярных транзисторов на основе GaAs с тонкой базой при возникновении в них нанометровых кластеров радиационных дефектов под действием нейтронного облучения** 1520
- Резник Р.Р., Котляр К.П., Штром И.В., Сошников И.П., Кукушкин С.А., Осипов А.В., Цырлин Г.Э.  
**Синтез методом молекулярно-пучковой эпитаксии  $A^{III}B^V$  нитевидных нанокристаллов ультра малого диаметра на сильно рассогласованной подложке SiC/Si(111)** 1525
- Алешкин В.Я., Байдусь Н.В., Дубинов А.А., Кудрявцев К.Е., Некоркин С.М., Новиков А.В., Рыков А.В., Самарцев И.В., Фефелов А.Г., Юрасов Д.В., Красильник Ф.  
**Технология изготовления лазерных диодов из структур GaAs/InGaAs/AlGaAs, выращенных на Ge/Si подложке** 1530
- Борисов В.И., Кувшинова Н.А., Курочка С.П., Сизов В.Е., Степушкин М.В., Темирязов А.Г.  
**Полупроводниковые структуры с одномерным квантовым каналом и планарными боковыми затворами, созданные методом импульсной силовой нанолитографии** 1534
- Мурель А.В., Шмагин В.Б., Крюков В.Л., Стрельченко С.С., Суwegeина Е.А., Шашкин В.И.  
**Емкостная спектроскопия дырочных ловушек в высокоомных структурах арсенида галлия, выращенных жидкофазным методом** 1538
- Тарасова Е.А., Оболенский С.В., Галкин О.Е., Хананова А.В., Макаров А.Б.  
**Анализ параметров GaN-HEMT до и после гамма-нейтронного воздействия** 1543
- Туркевич Р.В., Демиховский В.Я., Протогенов А.П.  
**Особенности циклотронного резонанса в трехмерных топологических изоляторах** 1547
- Фатеев Д.В., Машинский К.В., Qin Hua, Sun Jiandong, Попов В.В.  
**Гигантский эффект выпрямления терагерцового излучения в периодических графеновых плазмонных структурах** 1552
- Хомицкий Д.В., Лаврухина Е.А., Чубанов А.А., Нжийа Н.  
**Релаксация энергии в квантовой точке на крае двумерного топологического изолятора** 1557
- Никифоров В.Е., Абрамкин Д.С., Шамирзаев Т.С.  
**Люминесценция приповерхностного гетероперехода GaAs/AlAs в гетероструктурах на основе AlAs** 1565
- Акимов А.Н., Климов А.Э., Супрун С.П., Эпов В.С.  
**Влияние поверхности на транспортные явления в пленках  $PbSnTe : In/BaF_2$**  1569
- Акимов А.Н., Климов А.Э., Пашин Н.С., Ярошевич А.С., Савченко М.Л., Эпов В.С., Федосенко Е.В.  
**Связь длинноволновой границы чувствительности пленок  $PbSnTe:In$ , полученных методом молекулярно-лучевой эпитаксии, с их составом и структурой** 1574
- Байдусь Н.В., Алешкин В.Я., Дубинов А.А., Кудрявцев К.Е., Некоркин С.М., Новиков А.В., Павлов Д.А., Рыков А.В., Сушков А.А., Шалеев М.В., Юнин П.А., Юрасов Д.В., Яблонский А.Н., Красильник З.Ф.  
**Особенности выращивания лазерных структур InGaAs/ GaAs/AlGaAs методом МОС-гидридной эпитаксии на подложках Ge/Si** 1579